	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN202H (先科专用)	文件编号	临时
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	1/2

1 主要用途与主要特点

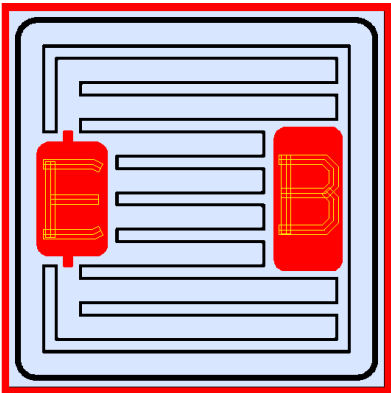
1.1 主要用途

用 W2XN202H 封装的成品管主要用于功放输出推动管及电器控制用管。

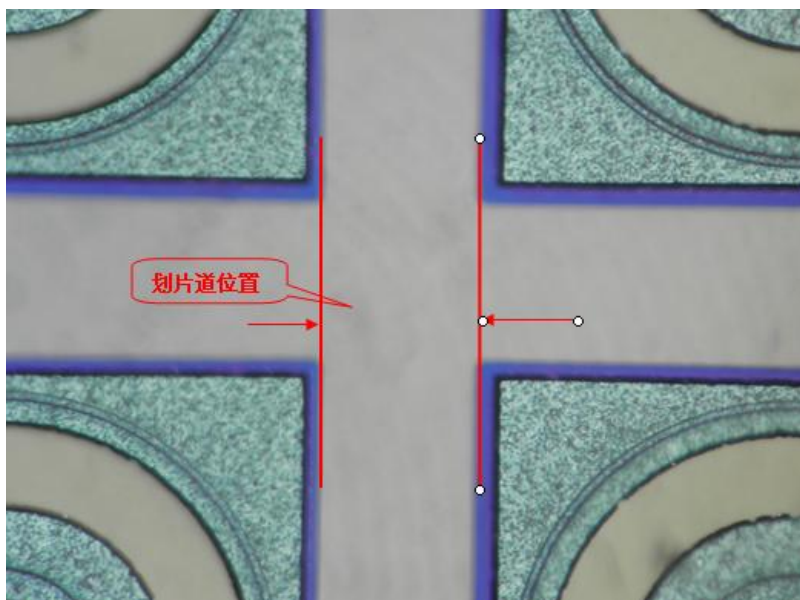
1.2 主要特点

- I_{CM} 大、 V_{CESat} 低，二次击穿耐量高

2 芯片数据

	芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	1.97×1.97	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	250±20		
	划片道*尺寸 (μm)	70		
	键合区面积 (μm ²)	基区	347×935	
		发射区	359×581	
	钝化层	Si ₃ N ₄		
	正面电极金属	金属	铝	
		厚度	5.0±0.6	
	背面电极金属	金属	银	
	硅片直径 (mm)	Φ125		
装片要求(推荐)	焊料			
键合要求(推荐)	铝丝: Φ200μm; E、B区各一根			

* 划片道位置示意图:




江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN202H (先科专用)	文件编号	临时
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B1-06
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	60	V	推荐封装形式: T0-220 推荐成品型号: 2396
集电极-发射极电压	V_{CE0}	60	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	7	V	
集电极电流	I_C	6	A	
耗散功率	P_D	2	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=60\text{V}, I_E=0$			100	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=7\text{V}, I_C=0$			100	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=500\text{mA}$	100		300	
基极-发射极电压	$V_{BE(on)}$	$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-1.5\text{A}$			1	V
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3\text{A}, I_B=300\text{mA}$			1	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=500\text{mA}$ $f=1\text{MHZ}$	5			MHz

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532